

D2SB□A

800V 2A

特長

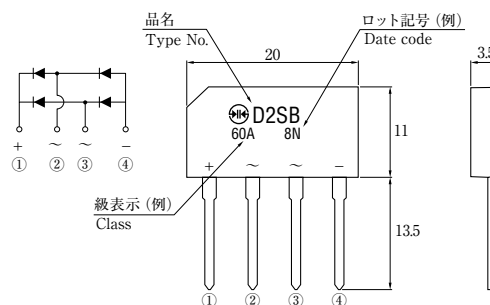
- 薄型 SIP パッケージ
- 高 I_{FSM}

Feature

- Thin-SIP
- Large I_{FSM}

■外観図 OUTLINE

Package : 2S

Unit : mm
Weight : 2g (typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

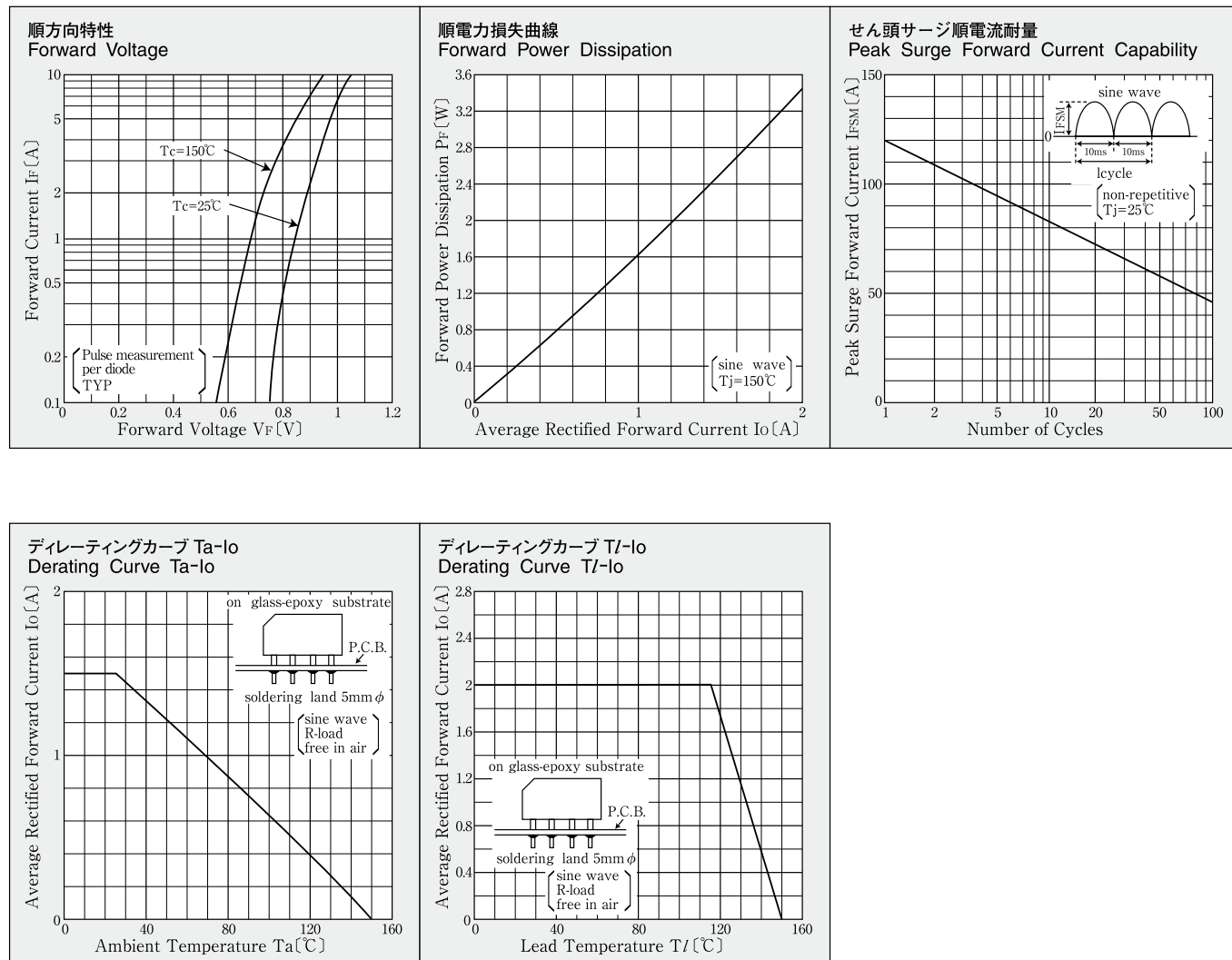
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions		品 名 Type No.	D2SB60A	D2SB80A	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}				- 40～150		℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j				150		℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}				600	800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	T/= 115℃	2		A	
			T _a = 25℃	1.5			
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, T _j = 25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, T _j = 25℃			120		A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms≦t<10ms, T _j = 25℃, 1 素子当たりの規格値 per diode			60		A ² s

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 1\text{A}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX	0.95	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX	10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jl}	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX	10	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	θ_{ja}	接合部・周囲間 Junction to Ambient	MAX	47	

特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.